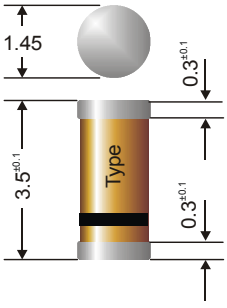
Surface Mount Si-Schottky Barrier Diodes | **Silizium-Schottky-Dioden für die Oberflächenmontage**



Dimensions / Maße in mm

Nominal current Nennstrom	0.2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20…40 V
Glass case MiniMELF Glasgehäuse MiniMELF	SOD 80 DO-213AA
Weight approx.– Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings and Characteristics | **Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] / I_F = 20 mA	 V_F [V] / I_F = 200 mA
LL 103C	20	< 0.37	< 0.6
LL 103B	30	< 0.37	< 0.6
LL 103A	40	< 0.37	< 0.6

Power dissipation – Verlustleistung		T_A = 25 °C	P_{tot}	400 mW[1])
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle		T_A = 25°C	I_{FSM}	15 A
Leakage current – Sperrstrom	T_j = 25°C	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 5 µA
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	V_R = 0 V	f = 1 MHz	C_{tot}	typ. 50 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	I_F = 200 mA through/über I_R = 200 A to/auf I_R = 20 mA		t_{rr}	typ. 10 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur			T_j	+125°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur			T_S	- 55...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 300 K/W [1])

[1]) Valid provided that terminals are kept at ambient temperature
Gültig wenn Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden